

2SC1667

シリコン NPN エピタキシャルベースメサ型/Si NPN Epitaxial Base Mesa

低周波大電力増幅用/AF Power Amplifier

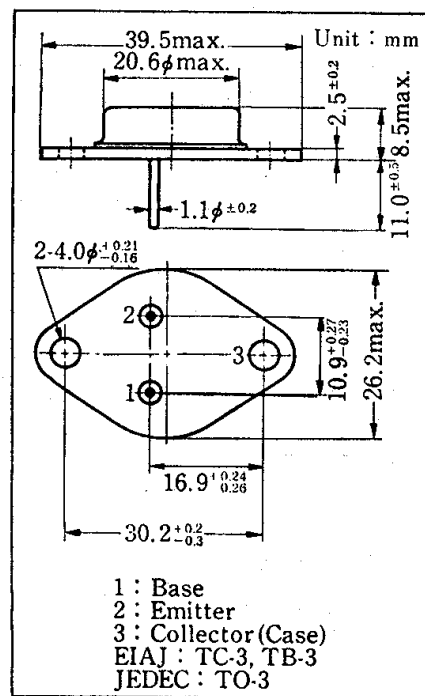
2SA837 とコンプリメンタリ/Complementary Pair with
2SA837

特 徴/Features

- 安全動作領域 ASO が広い/Wide area of safe operation
- 2SA837 とコンプリメンタリペアで出力 30~35 W が得られます。/
30~35 W output in complementary pair with 2SA837

最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	90	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	90	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CM}	6	A
コレクタ電流	I_C	4	A
コレクタ損失 (Tc≤75°C)	P_C	5.0	W
接合部温度	T_j	150	°C
保存温度	T_{stg}	-65~+150	°C



電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C=0.1A, I_B=0^{*1}$	90			V
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=50V, I_E=0$			1.0	mA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5V, I_C=0$			2.0	mA
直流電流増幅率	h_{FE1}^{*}	$V_{CE}=4V, I_C=1A^{**}$	40		200	
	h_{FE2}	$V_{CE}=4V, I_C=3A^{**}$	20			
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE}=4V, I_C=3A^{**}$			1.5	V
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=4A, I_B=0.4A^{**}$			2.0	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=10V, I_C=0.5A$		10		MHz

* h_{FE1} ランク分類/ h_{FE1} Classifications

h_{FE1}	40~80	70~140	100~200
分類	R	Q	P

** パルス測定/Pulse measurement